

サーマルCVD装置 CT-6000



炭化ケイ素(SiC)に代表される超高温材料は、その生成温度と濃度によって様々な結晶構造をとります。CT-6000はこれらの未来材料の研究をするために、制御圧力範囲を6.65～101KPa、制御温度範囲を800～2000℃と幅広く条件を取れるようになっています。

サーマルCVD装置 CT-6000仕様

| | |
|-----------|--|
| ○膜種 | SiC/C |
| ○炉体サイズ | φ168mm×210mm |
| ○炉体材質 | カーボン |
| ○基板形状 | 自在 |
| ○到達圧力 | ×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時 |
| ○排気速度 | ×10 ⁻¹ Pa台迄5分以内※常温・無負荷・脱ガス時 |
| ○加熱温度 | 2000℃ |
| ○圧力コントロール | 自動 |
| ○ガス種 | SiCl ₄ /C ₃ H ₈ /H ₂ /N ₂ |
| ○真空排気系 | 油回転ポンプ:1200L/min メカニカルブースターポンプ:300m ³ /h |
| ○真空計 | ピラニ真空計/バロトロン真空計 |
| ○ユーティリティ | 電気:AC200V三相60KVA 冷却水:60L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 |